

9012SS

硅 PNP 外延平面晶体管芯片 (4 ")

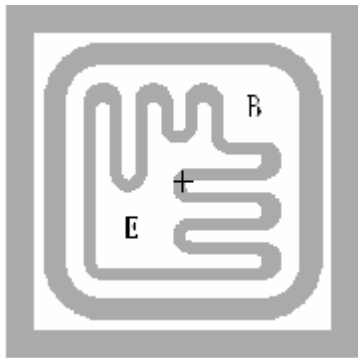
■用途:

- *一般用途放大器
- *中等功率驱动器
- *中速开关应用

■特征:

- *优越的 h_{FE} 线性
- *与 9013SS 配对
- *集电极电流:0.5A
- *有效管芯数(只):44768

■芯片示意图



■芯片结构

芯片尺寸	400 μ m \times 400 μ m
压焊区尺寸	基 区 89 μ m \times 89 μ m 发射区 89 μ m \times 89 μ m
芯片厚度	220 \pm 10 μ m
锯片槽宽度	60 μ m
金属层	正面:Al 1.85 \pm 0.15 μ m 背面:Au 1.1 \pm 0.2 μ m

■电特性(Ta=25°C)

参数名称	符号	测试条件	最小	最大	单位
集电极--基极击穿电压	BV_{CBO}	$I_C = -100 \mu A, I_E = 0$	-40		V
集电极--发射极击穿电压	BV_{CEO}	$I_C = -1 mA, I_B = 0$	-20		V
发射极--基极击穿电压	BV_{EBO}	$I_E = -100 \mu A, I_C = 0$	-5		V
集电极--基极截止电流	I_{CBO}	$V_{CB} = -25 V, I_E = 0$		-200	nA
发射极--基极截止电流	I_{EBO}	$V_{EB} = -4 V, I_C = 0$		-200	nA
直流电流增益	h_{FE}	$V_{CE} = -1 V, I_C = -50 mA$	80	600	
集电极--发射极饱和电压	$V_{CE(sat)}$	$I_C = -500 mA, I_B = -50 mA$		-0.6	V